

# JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

VĚDECKO-TECHNICKÝ ČASOPIS  
ROČNÍK 55 5/2010

## OBSAH

Počítačem generované hologramy (M. Škereň, P. Fiala) ....	135
Technologie výroby Schottkyho emisních katod zdokonalenou metodou elektrolytického leptání (A. Knápek, P. Paračka, M. Chvátal).....	139
<b>ELEKTRO EXPO</b> .....	141
Elektro-ultrazvuková spektroskopie na hořčíkových slitinách (P. Tofel, J. Šikula, V. Sedláková, T. Trčka).....	142
Současné trendy a možnosti v bezkontaktní analýze tvaru optických ploch (P. Kajnar, M. Kajnar).....	145
Amplitudové parametry drsnosti matnic v závislosti na druhu brusiva (M. Havelková, H. Hiklová).....	149
Prof. Karel Studenovský sedmdesátiletý (J. Hošek) .....	151
Základní struktura a subsystémy radaru (J. Pospíšil, F. Pluháček).....	152
<b>Seminář OPTONIKA 2010</b> (M. Jedlička) .....	156
Subaperturní sešívací interferometrie výrazně asférických ploch pomocí konfigurovatelné nulové optiky (A. Kulawiec, M. Bauer, G. DeVries, J. Fleig, G. Forbes, D. Miladinovic, P. Murphy).....	157
<b>O QED TECHNOLOGIES</b> .....	159
AMPER 2010 – Závěrečná zpráva.....	159

# FINE MECHANICS AND OPTICS

SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL  
VOLUME 55 5/2010

## CONTENTS

Computer Generated Holograms (M. Škereň, P. Fiala).....	135
Technology of Schottky emission cathodes fabrication using improved electrochemical etching method (A. Knápek, P. Paračka, M. Chvátal).....	139
<b>ELEKTRO EXPO</b> .....	141
Electro-ultrasonic spectroscopy of magnesium composites (P. Tofel, J. Šikula, V. Sedláková, T. Trčka) .....	142
Actual trends and potentials of contactless analysis of optical surface shapes (P. Kajnar, M. Kajnar).....	145
Amplitude parameters of ground glass roughness in dependence on chosen abrasive (M. Havelková, H. Hiklová) .....	149
Prof. Karel Studenovský in his seventieth (J. Hošek).....	151
Basic structure and subsystems of a radar (J. Pospíšil, F. Pluháček).....	152
Workshop OPTONIKA 2010 (M. Jedlička) .....	156
Subaperture stitching interferometry of high-departure aspheres by incorporating configurable null optics (A. Kulawiec, M. Bauer, G. DeVries, J. Fleig, G. Forbes, D. Miladinovic, P. Murphy) .....	157
<b>ABOUT QED TECHNOLOGIES</b> .....	159
AMPER 2010 – Final report .....	159

Bližší informace o poslání časopisu, pokyny pro autory, obsah časopisu apod. je uveden na internetu: <http://jmo.fzu.cz/>

Informace o předplatném podá, objednávky přijímá, objednávky do zahraničí vyřizuje: SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc, tel.: 585 223 936, fax: 585 631 531.

Cena čísla 40 Kč včetně DPH

For further information about the journal intention, instructions for authors, contents etc. please refer to <http://jmo.fzu.cz/>

Information on subscription rate and on ordering gives the SLO UP a FZÚ AV ČR, Tř. 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc, tel.: 585 223 936, fax: 585 631 531.

Price for single copy: 40 Kč incl. VAT

# CONTENTS

<b>Computer Generated Holograms</b> (M. Škereň, P. Fiala).....	135	This text is directed to the summarized description and physical interpretation of the basic structure of a radar from the standpoint of the theory of signal processing. After introductory and functional classification of radars, this text contains the treatise of a representative radar block model and of the characteristic signal properties of partial radar subsystems, containing the radar transmitter with signal waveform generator, radar antenna and radar receiver with the signal and data processor and display. For better orientation in the problems, the English synonyma are added to some established Czech expressions.
<b>Keywords:</b> computer generated holograms, diffraction of light, diffraction grating, iterative Fourier transform algorithm, electron beam lithography, laser lithography		
<b>Technology of Schottky emission cathodes fabrication using improved electrochemical etching method</b>		
(A. Knápek, P. Paračka, M. Chvátal).....	139	
The paper introduces a method for fabrication of microscopic cathode based on Schottky field emission. Schottky emission is the predominant electron source technology in actual focused electron beam equipment, including scanning electron microscopy (SEM), (TEM) transmission electron microscopy, Auger systems, and semiconductor inspection tools. Achieving proper results requires an electron source with the following ideal properties: small source size, low electron emission energy spread, high brightness (beam current per solid angle), low noise and long-term stability, simple and low-cost operation. Recently new technical modifications have been made in order to improve current fabrication methods. Widely used "drop off" method was further improved in order to allow reproducible tip fabrication with ultra sharp tips which radius reaches tens of nanometres.		
<b>Keywords:</b> Schottky emission cathodes fabrication, electrolytic etching		
<b>ELEKTRO EXPO</b> .....	141	
<b>Actual trends and potentials of contactless analysis of optical surface shapes</b> (P. Kajnar, M. Kajnar).....	145	<b>Elektro-ultrazvuková spektroskopie na horčíkových slitinách</b> (P. Tofel, J. Šikula, V. Sedláková, T. Trčka)..... 142
The surface topography persists for a long time in the forefront interest of many research and development organisations due to the perpetual quest for more precise and perfect measurement methods. So far used contact methods cannot be applied in many cases where their application can damage the measured surface and therefore waste the measured element, for instance lens surface or silicon plates etc. The great effort is therefore devoted to the development of contactless methods that employ various physical principles. In this article the brief description of light interference is presented including some algorithms for evaluation of the interference field and potentials of actual measuring instruments manufactured by prestigious producers and examples of model which are available at the today market.		Pomocí elektro-ultrazvukové nedestruktivní spektroskopie byl testován vzorek z hořčíkové slitiny. Tato metoda je založena na střídavém elektrickém proudu o frekvenci $f_E$ , který prochází vzorkem a ultrazvukovým vlněním o frekvenci $f_U$ . Na rozdílové a součetové frekvenci těchto dvou signálů vzniká nový intermodulační signál $f_m$ . Velikost tohoto signálu je závislá jak na velikosti budicích signálů, tak na struktuře testovaného materiálu a celkových defektech obsažených ve vzorku. Resistivita materiálu se mění v závislosti na ultrazvukovém vlnění. Ultrazvukový signál mění oblast kontaktu mezi vodivými zrny ve struktuře materiálu s frekvencí ultrazvukového vlnění $f_U$ . Tímto se mění proudová hustota ve vzorku, protože elektrický náboj a proud procházející vzorkem jsou konstantní. Předpokládáme, že vzorky, které obsahují více defektů ve své struktuře, budou mít vyšší hodnotu změny odporu než vzorky bez defektů.
<b>Keywords:</b> interference, contactless tomography, algorithm, measuring instrument		<b>Klíčová slova:</b> elektrický signál, ultrazvukový signál, změna odporu
<b>Amplitude parameters of ground glass roughness in dependence on chosen abrasive</b> (M. Havelková, H. Hiklová) .....	149	<b>Subaperture sešívací interferometrie výrazně asférických ploch pomocí konfigurovatelné nulové optiky</b> (A. Kulawiec, M. Bauer, G. DeVries, J. Fleig, G. Forbes, D. Miladinovic, P. Murphy)..... 157
This article is focused on the surface assessment of some ground glasses grinded by means different sorts of abrasion dust. It determines amplitude roughness parameters of ground glass samples and related PSD functions. Measurements were done by means of mechanical inductive profilometer Form Talysurf Series 2 – both software and hardware gear for solid surface assessment of shape, waviness and roughness with extraordinary resolution.		Metoda SSI (Subaperture Stitching Interferometry) byla původně vyvinuta pro měření celých apertur rozměrných koulí a rovin s využitím komerčních čtyř nebo šestipalcových interferometrů a transmisních prvků. Metoda pak byla rozšířena pro měření mírně asférických povrchů pomocí nejlepšího lokálního proložení, nazvětšováním velmi hustých interferenčních proužků a propojením s nenulovou interferometrií. V obou případech byl vyvinut vylepšený sešívací algoritmus automaticky kompenzující systematické chyby interferometru, jako jsou referenční vlnoplocha a distorzní chyby. Tento sešívací druh interferometrie rovněž poskytuje větší příčné prostorové rozlišení než konvenční interferometrie. Metoda byla dále rozšířena na výrazně asférické povrchy s využitím stavitelného optického zařízení VON™ (variable optical null). VON má různé realizace, které slouží ke generování vlnoplochy přesně lokálně kopírující povrch asféry. Zbytková odchylka od vlnoplochy je měřena standardním interferometrem a celý profil asféry je rekonstruován pomocí vylepšeného sešívacího algoritmu. Metoda umožňuje přesné změření asféry s odchylkou až 1000 vlnových délek od koule nejlepšího proložení, bez nutnosti použití jednoúčelových nulových čoček. V příspěvku se uvádějí základní principy této interferometrické metody využívající určité zařízení VON.
<b>Keywords:</b> Surface roughness, ground glass, profilometer, PSD function		<b>Klíčová slova:</b> asféry, metrologie, interferometrie, sub-aperture stitching
<b>Prof. Karel Studenovský in his seventieth</b> (J. Hošek).....	151	<b>O QED TECHNOLOGIES</b> ..... 159
<b>Basic structure and subsystems of a radar</b>		
(J. Pospíšil, F. Pluháček).....	152	

## ANOTACE

**Elektro-ultrazvuková spektroskopie na horčíkových slitinách** (P. Tofel, J. Šikula, V. Sedláková, T. Trčka)..... 142

Pomocí elektro-ultrazvukové nedestruktivní spektroskopie byl testován vzorek z hořčíkové slitiny. Tato metoda je založena na střídavém elektrickém proudu o frekvenci  $f_E$ , který prochází vzorkem a ultrazvukovým vlněním o frekvenci  $f_U$ . Na rozdílové a součetové frekvenci těchto dvou signálů vzniká nový intermodulační signál  $f_m$ . Velikost tohoto signálu je závislá jak na velikosti budicích signálů, tak na struktuře testovaného materiálu a celkových defektech obsažených ve vzorku. Resistivita materiálu se mění v závislosti na ultrazvukovém vlnění. Ultrazvukový signál mění oblast kontaktu mezi vodivými zrny ve struktuře materiálu s frekvencí ultrazvukového vlnění  $f_U$ . Tímto se mění proudová hustota ve vzorku, protože elektrický náboj a proud procházející vzorkem jsou konstantní. Předpokládáme, že vzorky, které obsahují více defektů ve své struktuře, budou mít vyšší hodnotu změny odporu než vzorky bez defektů.

**Klíčová slova:** elektrický signál, ultrazvukový signál, změna odporu

**Subaperture sešívací interferometrie výrazně asférických ploch pomocí konfigurovatelné nulové optiky** (A. Kulawiec, M. Bauer, G. DeVries, J. Fleig, G. Forbes, D. Miladinovic, P. Murphy)..... 157

Metoda SSI (Subaperture Stitching Interferometry) byla původně vyvinuta pro měření celých apertur rozměrných koulí a rovin s využitím komerčních čtyř nebo šestipalcových interferometrů a transmisních prvků. Metoda pak byla rozšířena pro měření mírně asférických povrchů pomocí nejlepšího lokálního proložení, nazvětšováním velmi hustých interferenčních proužků a propojením s nenulovou interferometrií. V obou případech byl vyvinut vylepšený sešívací algoritmus automaticky kompenzující systematické chyby interferometru, jako jsou referenční vlnoplocha a distorzní chyby. Tento sešívací druh interferometrie rovněž poskytuje větší příčné prostorové rozlišení než konvenční interferometrie. Metoda byla dále rozšířena na výrazně asférické povrchy s využitím stavitelného optického zařízení VON™ (variable optical null). VON má různé realizace, které slouží ke generování vlnoplochy přesně lokálně kopírující povrch asféry. Zbytková odchylka od vlnoplochy je měřena standardním interferometrem a celý profil asféry je rekonstruován pomocí vylepšeného sešívacího algoritmu. Metoda umožňuje přesné změření asféry s odchylkou až 1000 vlnových délek od koule nejlepšího proložení, bez nutnosti použití jednoúčelových nulových čoček. V příspěvku se uvádějí základní principy této interferometrické metody využívající určité zařízení VON.

**Klíčová slova:** asféry, metrologie, interferometrie, sub-aperture stitching